





PN - JP61285424 A 19861216

PD - 1986-12-16

PR - JP19850128983 19850613

OPD - 1985-06-13

TI - OPTICAL BEAM DEFLECTOR

IN - ADACHI HIDEO

PA - OLYMPUS OPTICAL CO

IC - G02B26/10

CT - JP52116252 A []; JP48074245 A []

OQL/LAG

PN - JP61285424 A 19861216

PD - 1986-12-16

AB

AP - JP19850128983 19850613

IN - ADACHI HIDEO

PA - OLYMPUS OPTICAL CO LTD

TI - OPTICAL BEAM DEFLECTOR

- PURPOSE:To obtain a comparatively large displaced variable quantity by fixing respective base ends of bimorph type piezo-electric elements on a base board so that respective terminals are displaced in the contacting/separating direction with/from the base board and supporting a reflection mirror to reflect an optical beam by the mirror.

- CONSTITUTION: Three projection parts11-13 are formed on one side surface of the cylindrical base board 10 having 15mm inner diameter and 25mm outer diameter and made of metal such as SUS and titanium. Respective base ends of the bimorph type piezo-electric elements 21-23 are fixed on the projection parts 11-13 with a bonding agent. The elements 21-23 are shaped like circular arcs and respective leading ends are extended in the circumferential direction of the base board 10 so as to be displaced. One electrode plate of the elements 21-23 is connected to terminals 41-43 through lead wires 31-33 and the other electrode plate is connected to the conductive part of the base board. The conductive part is connected to a terminal through a lead wire 34 and three-corner parts 51-53 of an optical beam reflecting mirror 50 shaped like a regular triangle are supported by the respective leading end parts of the elements 21-23 through flexible members.

- G02B26/10

Best Available Copy

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 285424

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和61年(1986)12月16日

G 02 B 26/10

101

7348-2H

審査請求 未請求 発明の数・1 (全5頁)

②発明の名称

光ビーム偏向器

到特 昭60-128983 顖

29出 昭60(1985)6月13日

⑫発 明 安達 日出夫 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

①出

オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

弁理士 坪 井 外2名

1. 発明の名称

光ピーム偏向器

2. 特許請求の範囲

、基台と、この基台上に各基端を固定されそれぞ れの先端が前記基台に対して接離する方向へ変位 可能な如く設けられたパイモルフ型圧電素子と、 これらのバイモルフ型圧電素子の各先端により支 持され光ピームを反射する如く設けられた反射ミ ラーとからなる圧電式アクチュエータを備えたこ とを特徴とする光ビーム偏向器。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はレーザ光等の光ピームを所定角度に倡 向する光ピーム偏向器に関し、特に反射ミラーの 角度を駆動制御するアクチュエータの改良に関す

(従来の技術)

る光ビーム偏向器においては、レーザ光ビームを XーY方向に走査するスキャナを必要とする。こ のスキャナにおける反射ミラーを駆動制御するア クチュエータとして、圧電素子を利用した圧電式 アクチュエータが研究されている。

第3図はこれまでに研究開発された従来の圧電 式アクチュエータの一例を示す斜視図である。第 3 図において1 は基台であり、この基台1上には 4個の積層型圧電素子2a~2dが正四角形の各 コーナ部に位置するように配置されている。これ らの積層型圧電素子2a~2dの各上端には、反 射ミラー3の四脚3a~3dの各先塡部が結合さ れている。

上記構成の圧電式アクチュエータにおいては、 積層型圧電素子2aと2cに電圧を印加しない状 態において、積簡型圧電素子2bと2dに極性が 反対の電圧を同時に印加すると、反射ミラー3は X輪を中心に回動する。また上記とは逆に積層型 レーザ文字描画装置、レーザ類散鏡等に用いられ いて、積層型圧電素子2aと2cに極性が反対の

電圧を印加すると、反射ミラー3はY軩を中心に 回動する。かくして發展型圧電素子2a~2dに 印加する電圧を適宜制御し、積層型圧電素子2a ~2dの上蜀を矢印で示すように上下方向に伸縮 動作させて反射ミラー3の角度を順次変更制御す ることにより、反射ミラー3によってレーザ光の 個向が行われ、XーY走査が行なわれることにな る。なお積層型圧電素子2a~2dは強誘電体で あるジルコンチタン酸鉛(PZT)にて形成され ているため、いわゆるヒステリシス特性を有して いる。このため上記圧電式アクチュエータを実用 に供する場合には、高精度な位置センサと共にク ロースド・ループ・システムを構成し、上記セン サーからの信号に基いてヒステリシスの影響が生 じないように、印加する電圧の大きさを制御する 必要がある。上記ヒステリシスの問題を解決する 手段として、積層型圧電素子2a~2dの代りに ヒステリシス特性を有していない電歪素子を用い ることが考えられる。しかし第 4 図の A . B 曲線 に示すように、電査素子は圧電素子に比べて温度

特性が著しく悪い。このため格別の温度福度手段を設けなければならず、実用には供し難たい。

(発明が解決しようとする問題点)

前記した圧電式アクチュエータによれば、他の型式のアクチュエータに比べ、①高速度応答が可能である、②ランダムスキャンが容易に行なえる、③構造が小型で軽量なものとなる、等の長所がある。しかしながら次のような解決すべき問題があった。

(1) 積層型圧電素子2 a~2 d は500

[V_{P-P}] , 100[ht]の電圧を印加したとき、5.6[m.rad]程度の偏向角が得られるだけであり、偏向角が比較的小さいという欠点がある。すなわち第5図のC.D線にて示すように、一般に積層型圧電素子はパイモルフ型圧電素子に比べて印加電圧に対する変位量が小さい。なお第4図の特性はクローズド・ループでヒステリシスを補償した場合のものである。

(2)積層型圧電素子が発生する変位力はバイモルフ型圧電素子等に比べて非常に大きい。 しかる

(3) 積層型圧電素子2 a ~ 2 d は 薄い 圧電 セラミックスを多数枚積層する工程、積層された圧電セラミックスをリード線により並列接続する工程、等の煩雑な工程を必要としているので、コスト高になるという難点がある。

そこで本発明は、大きな個向角が得られ、無駄のない駆動制御を行ない得、しかも低コストで製作可能な圧電式アクチュエータを備えた光ピーム 個向器を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

(作用)

このような手段を調じたことにより、比較的大きな変位量が容易に得られると共に、パイモルフ型圧電素子の変位力が反射ミラーを駆動するのに丁度適した大きさのものとなる。また積層型圧電素子を使用する場合のような積層工程は全く不要であり、かつ並列接続工程も著しく簡単化することになる。

·(--実-施例).

第_1 図 (a)~(c)は本 発_明 の一 実 施 例 の 主

要部の構成を示す図で、(a)は光ビーム偏向器における圧電式アクチュエータの斜視図であり、
(b)は上記圧電式アクチュエータを真上からみた平面図であり、(c)は上記圧電式アクチュエータを真積からみた側面図である。

接続し、非接合面例の各電極板64.65を短絡 して前記端子44に相当する端子T2に接続して いる。(b)は直列構造のパイモルフ型圧電景子 70の構造を示す図である。このパイモルフ型圧 電素子70は一対の圧電セラミックス71、72 を矢印で示すように分極方向が反対となるように 接合し、非接合面側の一方の電極板74を前記端 子41~43に相当する端子T1に接続し、他方 の電極板75を前記端子44に相当する端子T2 に接続している。なお機械的強度を確保するため に、実際には圧電セラミックス61。62の間お よび71.72の間に薄い金属板のような補強材 を挟み込む場合が多い。上記以外にも、圧電セラ ミックスと、金属やプラスチックなどの非圧電セ ラミックスとを一体に接合し、圧電セラミックス の両側の電極板を端子T1、T2に接続した構造 ··-の-も-の-も-あ-る-。

第2図(a)に示す並列橋造のパイモルフ型圧 電素子60と、同図(b)に示す直列構造のパイ モルフ型圧電素子70とを比較すると、電圧を印「

第2図(a)(b)はバイモルフ型圧電素子2 1~23の構造例を示す側面図である。(a)は 並列構造のバイモルフ型圧電素子60を示す図で ある。このバイモルフ型圧電素子60は圧電セラ ミックス61.62を分極方向が矢印で示すよう に同一方向を向くように接合し、接合面の電極板 63を前記端子41~43に相当する端子T1に

加することにより大きな変位量を得る場合には (a)の方が適している。したがって本実施例に おける以下の説明では(a)を用いた場合を想定 して説明する。

上記パイモルフ型圧電素子60の変位量ム×および発生する変位カムFは、 .

 $\Delta x = 3 \ell^{2} \cdot d_{31} \cdot V / t^{2} \cdots (1)$

 $\Delta F = 36 t \cdot Vd_{31} \cdot E / 42 \cdots (2)$

ただし、E:ヤング率、ℓ:バイモルフ型圧電素子の長さ、t:バイモルフ型圧電素子の厚みである。

比較のために積層型圧電素子の変位量 Δ x および発生する変位力 Δ F を示すと、

 $\Delta x = n \cdot d_{33} \cdot V \cdots (3)$

 $\Delta F = S \cdot E \cdot \Delta \ell / \ell \cdots (4)$

ただし、 Δ & : 積層型圧電素子の変位量、であ

上記 (1) 式と (3) 式の比較から分るように、 積層型圧電素子の変位は寸法形状とは無関係であ るのに対し、バイモルフ型圧電素子の変位は寸法

このように構成された本実施例によれば、、第12(a)~(c)に示す各バイモルフ型圧電素子21には電圧を印加せず、バイモルフ型圧電素子22には+100[V]。バイモルフ型圧電素子22には-100[V]なる電圧を印加すると、約~には-100[V]なる電圧を印がまると、約~反射の変位が逆方向に生じる。を動としてシー50は第1図(b)の破線部分を動として

(発明の効果)

したがって本発明によれば、比較的大きな要位 量が容易に得られると共に、パイモルフ型圧電素 回動し、同図(c)に示すように、 θ なる傾きを生じる。その結果、 2θ なる角度に相当する傾きの角20[m. r a d]が得られる。この点、 積層型圧電素子の場合には500[V_{P-P}]の電圧を印加したとき、5.6[m. r a d]程度の偏向角が得られるに過ぎなかったのに比べると、 質向角が大幅に改善されたことになる。

なお本発明は、前記一実施.例に限定されるものではない。例えばバイモルフ型圧電素子として円

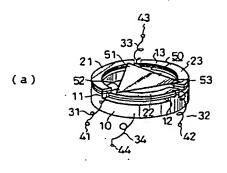
子の変位力が反射ミラーを駆動するのに丁度適した大きさのものとなる。また積層型圧電素子を使用する場合のような積層工程は全く不要である。な積層しく簡単化することにないる。 その結果、大きな偏向角が得られ、無駄のない駆動を行ない得しかも低コストで製作可能ないのである。 は、大きな偏向角が得られ、無駄のない駆動制を行ないは、しかも低コストで製作可能な圧電式アクチュエータを備えた光ビーム偏向器を提供することができる。

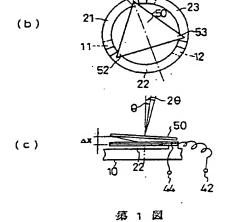
4. 図面の簡単な説明

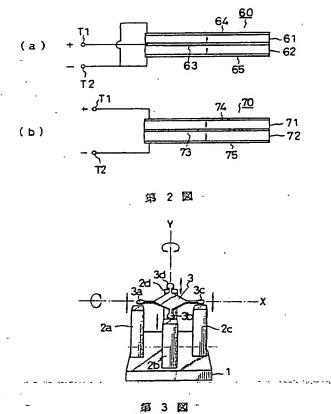
第1 図(a)(b)(c)は本発明の一実施例における主要部の構成を示す図、第2 図(a)(b)は同実施例のバイモルフ型圧電素子の構造例を示す側面図、第3 図は従来例の構成を示す斜視図、第4 図および第5 図は従来例の問題点を説明するための特性図である。

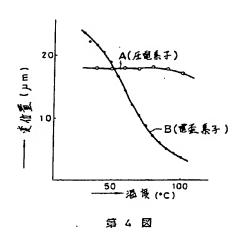
60 … 並列構造のバイモルフ型圧電素子、70 … 直列構造のバイモルフ型圧電素子、61.62 お よび71.72 … 圧電セラミックス、63~65 および73~75 … 電極板、T1.T2 … 端子。

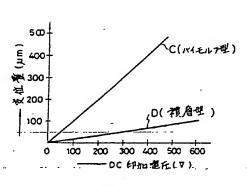
出願人代理人 弁理士 坪井 淳











第 5 図